

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. ⁶ H01L 29/772	(11) 공개번호 특 1996-0036128
	(43) 공개일자 1996년 10월 28일
(21) 출원번호 특 1996-0005641	
(22) 출원일자 1996년 02월 29일	
(30) 우선권주장 413,319 1995년 03월 30일 미국(US)	
(71) 출원인 모토로라 인코포레이티드	빈센트 비. 인그라시아
(72) 발명자 찰스 이. 웨이첼	미국, 일리노이 60196, 샤움버그, 이스트 엘공켄 로드 1303
	미국, 애리조나 85202, 메사, 웨스트 나란자 애비뉴 2222
	모히트 바트나가
	미국, 애리조나 85020, 메사, 사우스 루즈벨트 #2071 150
(74) 대리인 이병호, 최달용	

심사청구 : 없음

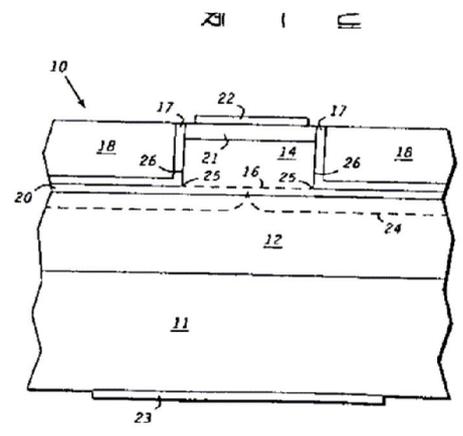
(54) 실리콘 탄화물 금속 산화물 반도체 전계효과 트랜지스터

요약

실리콘 탄화물 MOSFET(10)가 높은 항복전압을 갖도록 형성된다. 항복 강화층(20)은 채널 영역(14)과 드 리프트층(12) 사이에 형성된다. 항복 강화층(20)은 게이트 절연기(17) 부근의 공핍 영역(24)의 폭을 증가 시키는 낮은 도우핑 농도를 갖는다.

증가된 공핍 영역의 폭은 항복전압을 개량한다.

대표도



명세서

[발명의 명칭]

실리콘 탄화물 금속 산화물 반도체 전계효과 트랜지스터

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명에 따른 금속산화물 반도체 전계효과 트랜지스터의 확대 단면도.

본 건은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

